Intel会同Micron联合推出25纳米NAND—
半导体工业最小、最先进的工艺技术

世界首创的25纳米NAND技术可为当今流行消费类电子和计算设备上的更多数据、照片、歌曲提供高性价比路径

Santa Clara, Calif., and Boise, Idaho , 2010年2月1日 – Intel Corporation会同Micron Technology, Inc.（Nasdaq:MU）今天联合宣布了世界首创的25纳米（nm）NAND技术以及新型高性能级固态驱动器（SSD），前者可为
提高诸如智能手机、个人音乐及媒体播放器（PMP）等的流行消费类小机件提供性价比更高的路径。

NAND闪存可存储消费类电子产品上所含的数据和媒体，即使当关闭电源时后也可保留信息。面向体积更小NAND工艺迈进的驱动器可实现该技术崭新用途的持续开发和推广。25纳米工艺不仅是体积最小的NAND技术，而且是世界体积最小的半导体技术——
一种代表当今消费类电子产品和计算应用领域中更多音乐、视频及其他数据持续发展的技术成就。

由IM Flash
Technologies（IMFT），Intel与Micron的NAND闪存合资企业制造，25纳米工艺可在单个NAND设备上产生8千兆字节（GB）的存储能力，从而为当今的微型消费类小机件打造大容量存储解决方案。其尺寸仅为167毫米2——小到足以穿过光盘（CD）中间的孔，然而却封装了此类CD
10倍以上的数据容量（标准CD可存储700兆字节的数据）。

依托于关注NAND研发和加大这方面投资的承诺，Intel和Micron大概每隔18个月便可使NAND的密度翻一番，从而得以推出体积更小、性价比更高和容量更大的产品。IMFT于2006年以50纳米工艺开始量产，紧接着又于2008年开始了34纳米工艺的量产。依托于当今的25纳米工艺，这两家公司正以其在业界可用的最小半导体光刻为契机而拓展其加工和制造的领先地位。

“以最先进的工艺技术引导整个半导体工业的发展是Intel和Micron的惊人壮举，并且我们期待继续推进标度极限，”Brian
Shirley，Micron内存集团的副总裁说。“这一生产技术将通过密度越来越高的媒体解决方案而为我们的客户带来利益。”

“通过我们在IMFT上的持续投资，我们得以持续提供领先的技术和制造能力，从而推出性价比最高且最可靠的NAND内存，”Tom Rampone，Intel NAND Solutions
Group的副总裁兼总经理说。“这将有助于加速计算所用固态驱动器解决方案的推广。”

25纳米、8
GB设备目前正在采样，有望于2010年第二季度投入量产。对于消费类电子制造商来说，该设备可在单个2位/单元多层单元（MLC）压膜中提供最高的密度，符合行业标准，即薄型小尺寸封装（TSOP）标准。多个8GB设备可进行堆叠式封装，以提高存储容量。与以往多代的工艺相比，该新型25纳米8GB设备可少用50%的芯片，因此可实现尺寸更小，但密度更高的设计效果和更高的性价比。比如，

256GB的固态驱动器（SSD）现在仅可通过32个这样的设备而实现（先前为64个），32GB的智能手机仅需要四个，而16GB的闪存卡则仅需要两个。

相关链接

欲了解最新的Micron和Intel新闻，请访问：

- Micron Innovations Blog: www.micronblogs.com
- Micron on Twitter: http://twitter.com/microntechnews
- Micron Pressroom: www.micron.com/media
- Intel Pressroom: www.intel.com/pressroom
- Intel Blog: http://blogs.intel.com
- Intel on Twitter: http://twitter.com/intelnews

关于Intel

Intel（Nasdaq:INTC）是硅创新领域的世界领先者，致力于开发各类技术、产品和行动计划，以持续推进人们的工作和生活方式。有关Intel的其他信息可从站点www.intel.com/pressroom和http://blogs.intel.com上获取。有关Intel NAND闪存解决方案的更多详情，请访问www.intel.com/go/ssd。

Intel Corporation的徽标可访问站点http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=7015查阅

关于Micron

Micron Technology, Inc.是世界领先的先进半导体解决方案提供商之一。依托于其全球性运营，Micron致力于制造和营销前沿计算、消费、联网和移动产品所用的DRAM、NAND闪存、其他半导体部件和内存模块。Micron的普通股在NASDAQ上市交易，代号为MU。欲了解有关Micron Technology, Inc.的更详尽信息，请访问www.micron.com。 Intel和Intel徽标是Intel Corporation在美国及其他国家/地区的商标。

* 其他名称和品牌分别为其各自所有者的财产。

版权所有© 2010年， Micron Technology, Inc.和Intel Corporation。保留所有权利。信息随时变化，恕不另行通知。

Micron和Micron徽标是Micron Technology, Inc.的商标。

Micron Technology, Inc.的徽标可访问站点 http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950查阅

本新闻稿含有有关25纳米8GB NAND设备生产的前瞻性陈述。实际情况及结果可能与前瞻性陈述中所含的信息存在实质性不同。请参阅Micron以汇总方式随时在Securities and Exchange Commission备案的文档，尤其是Micron最新的Form 10-K和Form 10-Q。这些文档包含且识别从总体上讲可导致Micron的实际结果与前瞻性陈述中所含信息产生实质性不同的重要因素（参见Certain Factors）。尽管我们相信前瞻性陈述中所反映的预期是合理的，但我们无法保障未来结果、活动的水平、性能或成果。

CONTACT:
Kirstin Bordner
Micron Technology, Inc.
208-368-5487
kbordner@micron.com